

Silicon Fast Recovery Diode

 $V_{RRM} = 100\text{ V} - 600\text{ V}$
 $I_F = 40\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 600 V V_{RRM}

DO-5 Package

Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	FR40B(R)02	FR40D(R)02	FR40G(R)02	FR40J(R)02	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		100	200	400	600	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		70	140	280	420	V
DC blocking voltage	V_{DC}		100	200	400	600	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 100\text{ °C}$	40	40	40	40	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	500	500	500	500	A
Operating temperature	T_j		-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	°C
Storage temperature	T_{stg}		-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	°C

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FR40B(R)02	FR40D(R)02	FR40G(R)02	FR40J(R)02	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 40\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	1.4	1.4	1.4	1.4	V
Reverse current	I_R	$V_R = 100\text{ V}$, $T_j = 25\text{ °C}$	25	25	25	25	μA
		$V_R = 100\text{ V}$, $T_j = 125\text{ °C}$	10	10	10	10	mA

Recovery Time

Maximum reverse recovery time	T_{RR}	$I_F = 0.5\text{ A}$, $I_R = 1.0\text{ A}$, $I_{RR} = 0.25\text{ A}$	200	200	200	250	nS
-------------------------------	----------	---	-----	-----	-----	-----	----

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.8	0.8	0.8	0.8	°C/W
-------------------------------------	------------	--	-----	-----	-----	-----	------

Figure .1-Typical Forward Characteristics

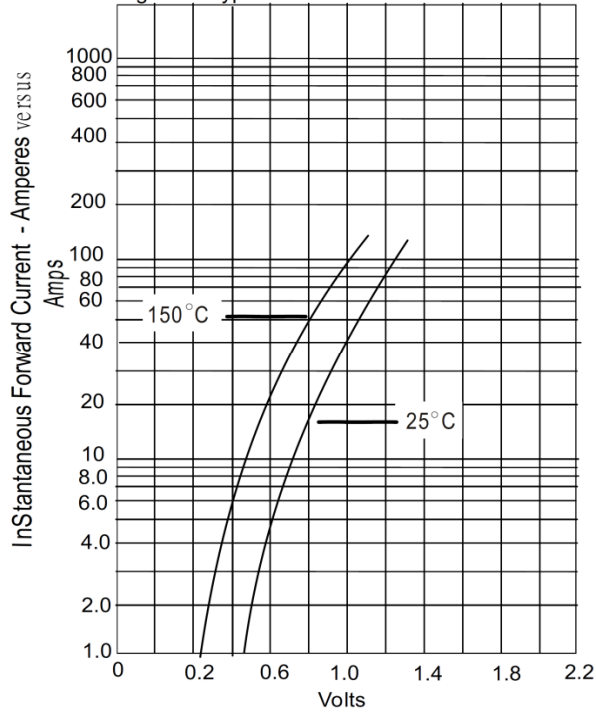
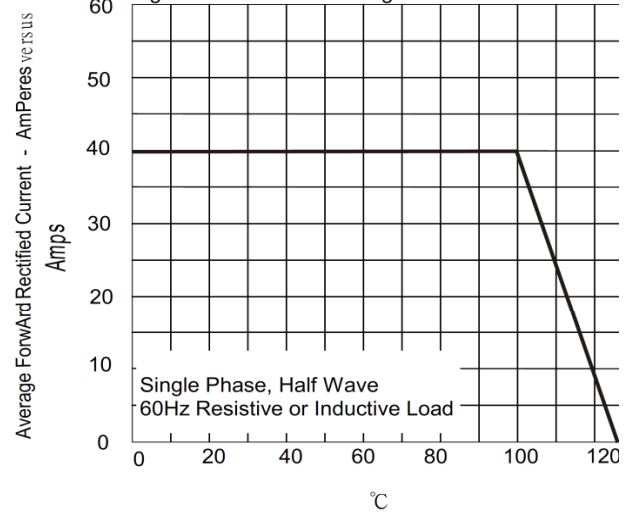


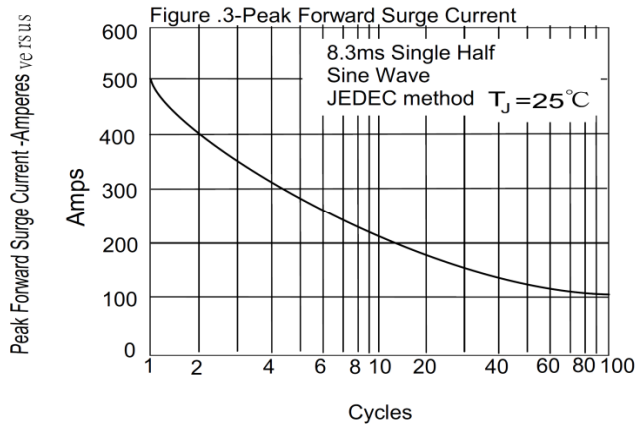
Figure .2- Forward Derating Curve



Case Temperature - °C

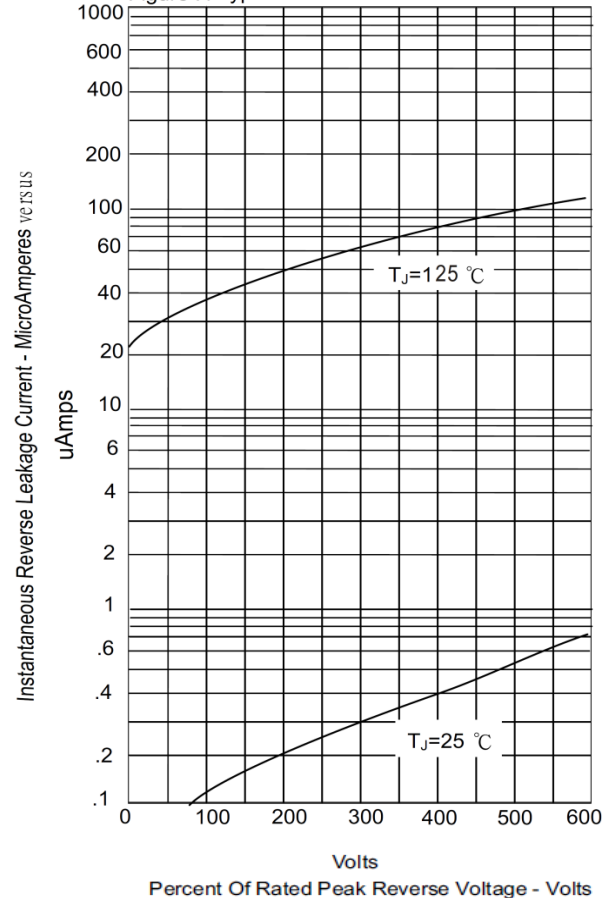
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure .3-Peak Forward Surge Current



Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

Figure .4-Typical Reverse Characteristics



Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9